

Módulo de Memória "Unbuffered" DDR2 de 1Gbyte

MW01GN5324U58

1 GigaByte, DDR2, PC2-4200 (533 MHz) CL4, DIMM 240 Pinos

MW01GN6625U58

1 GigaByte, DDR2, PC2-5300 (667 MHz) CL5, DIMM 240 Pinos

Descrição:

Os produtos **MW01GN5324U58** e **MW01GN6625U58** são módulos de memória de 1 Gigabyte, organizados como uma memória DRAM DDR2 de 128Mx64 bits. Cada módulo é composto de dezesseis CIs de DRAM DDR2 em encapsulamento FBGA e uma EEPROM serial na função de SPD (Detecção de Presença Serial — *Serial Presence Detection*), montados em um módulo DIMM de 240 pinos, com contatos dourados, segundo o padrão JEDEC.

Características:

- Mecânica DIMM de 240 pinos, *unbuffered*;
- Arquitetura DDR2 (*Double Data Rate*); duas transferências de dados por ciclo de clock;
- Controle de Terminação no *Die*;
- Utiliza DRAMs DDR2 na organização 64Mx8;
- Entradas de *clock* diferenciais;
- Tamanho de burst programável: 4 ou 8;
- Tempo de ciclo de *clock*: (MW01GN5324U58)
 - (t_{CK}) = 3.75 ns (mín.) / 8 ns (máx.) em CL=4
- Tempo de ciclo de *clock*: (MW01GN6625U58)
 - (t_{CK}) = 3.00 ns (mín.) / 8 ns (máx.) em CL=5
- EEPROM para Detecção de Presença Serial (SPD);
- Strobe* de dados bidirecional e diferencial (sinais DQS e /DQS);
- Quatro bancos internos para operação concorrente;
- Tempo de *Auto-Refresh* para estado Ativo (t_{RFC}): 105 ns (mín)
- Auto-precarga*
- Modos de *Auto-refresh* e *Self-refresh*;
- Endereços de linha: A_0 - A_{13}
- Endereços de coluna: A_0 - A_9
- Interface SSTL_18
- VDD = VDDQ = 1.8 V \pm 0.1 V

Especificações:

Símbolo	Característica AC	Mín.	Max.	Unid.
t_{CK}	MW01GN5324U58 CL=4	3750	8000	ps
	MW01GN6625U58 CL=5	3000		
t_{RC}	Tempo de Ciclo de Linha (Em Operação)	60	-	ns
t_{RAS}	Tempo de Linha Ativa	45	70.000	ns
t_{RFC}	Tempo de Auto-Refresh para Ativo / Comando de Auto-Refresh	105	-	ns

Valores Típicos:

	Valor	Unid.	Condição
Dissipação de Potência, 1 Banco Operando (Ativação de Linha, Precarga) + 1 Banco Ocioso (<i>Idle</i>) @VDD, VDDQ = 1.8V	MW01GN5324U58	2.016	W Ta=25°C
	MW01GN6625U58	2.160	
Temperatura de Operação ¹	0 ~ 85	°C	
Temperatura de Armazenagem	-55 ~ 100	°C	

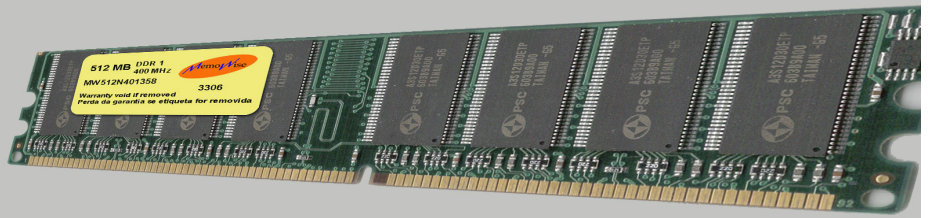
Nota:

1. Refere-se à temperatura no encapsulamento dos CIs de DRAM.

Todos os valores nesta folha de dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Memowise não assume nenhuma responsabilidade pelo uso desta informação, nem pela infração de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar de seu uso.

AVISO: NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À VIDA

NÃO SE AUTORIZA O USO DOS PRODUTOS MEMOWISE COMO COMPONENTES CRÍTICOS EM DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE SUPORTE À VIDA SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DE MEMOWISE TECNOLOGIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.



Módulo de Memória "Unbuffered" DDR2 de 1Gbyte

Dimensões

Todas as dimensões estão em milímetros (polegadas); a tolerância é $\pm 0.127\text{mm}$ (0.005") exceto onde indicado.

